

## 产品描述

EP2-15S1505 是专为需要两组隔离电源的 SIC MOSFET 驱动器专用电源。其内部采用了两路共地输出模式,可以更好的为 SIC 的开通与关断提供能量。同时具有输出短路保护及自恢复能力。



## 产品特点

- 效率高达80%
- SIP 封装
- 隔离电压 3500VAC
- 超小隔离电容
- 工作温度范围: -40℃ to +105℃
- 可持续短路保护
- 国际标准引脚方式

### 应用领域

- 通用变频器
- 交流伺服驱动系统
- 电焊机
- 不间断电源(UPS)交换机

### 选型表

	输入电压(VDC)	輸出	1	满载效率(%)	
产品型号	标称值 (范围值)	输出电压(VDC) +Vo/-Vo	输出电流(mA) +lo/-lo	Min./Typ.	最大容性负载*(µF)
EP2-15S1505	15 (13.5-16.5)	+15/-5	+100/-100	76/80	220
注: *每路输出容性负载一样。					

## 产品特性

产品特性							
产品特性	项目	工作条件		Min.	Тур.	Max.	单位
输入特性	输入电流(满载/空载)	15V 输入		162/15		mA	
	输入冲击电压(1sec. max.)		-0.7		21	VDC	
	输入滤波器			电容滤波			
	热插拔			不支持			
	松山市匠	Vin=15VDC, Pin6 & Pin7 +lo=+100mA	+Vo	14.4	15	15.9	VDC
	输出电压	Vin=15VDC, Pin5 & Pin6 -lo=-100mA	-Vo	-4.75	-5	-5.75	
	输出电压精度	Vin=15VDC, Pin6 & Pin7 +lo=+100mA	+Vo	-4% to +6%			
		Vin=15VDC, Pin5 & Pin6 -lo=-100mA -Vo -5% to +15%					
		10% 到 100% 负载		见误差包络曲线(见图 1)			
+ <b>◇</b> 1114±44	线性调节率	输入电压变化±1%	-	±1.1			
输出特性	负载调节率		+Vo	_	7		%
		10% 到 100% 负载	-Vo	_	9	%	%
	纹波&噪声*	00MI = ##\$	+Vo	_	120	-	
		20MHz 带宽	-Vo	_	80		mVp-p
	温度漂移系数	100% 负载		_	±0.02	-	%/℃
	输出短路保护			可持续,自恢复			
汉四址址	隔离电压	输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于	3500	-		VAC	
通用特性	绝缘电阻	输入-输出,绝缘电压 500VDC	1000			<b>M</b> Ω	



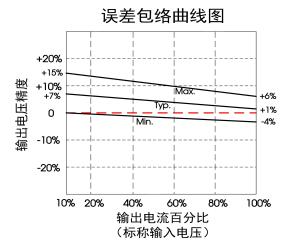
### SIC MOSFET 驱动器专用电源

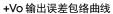
	隔离电容 输入-输出, 100kHz/0.1V		-	3.5		рF	
	工作温度	温度≥85℃降额使用(见图 2)	-40	-	105		
	存储温度		-55		125	°C	
	引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒			300		
	工作时外壳温升	<b>Ta=25</b> ℃		30	_		
	存储湿度	无凝结			95	%RH	
	开关频率 100%负载,输入标称电压		-	83		kHz	
	平均无故障时间(MTBF)	MIL-HDBK-217F@25℃	3500		-	k hours	
物理特性	外壳材料       黑色阻燃耐热塑料						
	封装尺寸	19.50 x 9.80 x 12.50mm					
	重量	4.2g (Typ.)					
	冷却方式						

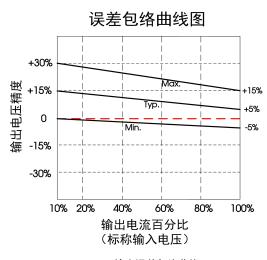
# EMC 特性

ENAL	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 5)
EMI	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 5)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±6kV perf. Criteria B

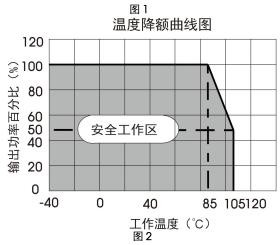
# 产品特性曲线







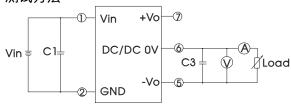
-Vo 输出误差包络曲线



### SiC MOSFET 驱动器专用电源

# 设计参考

1. 测试方法



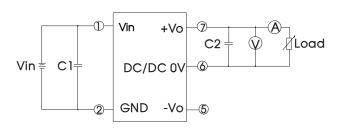
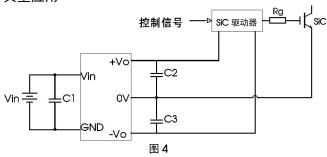


图 3

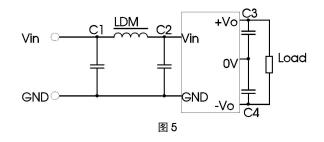
注: C1, C2, C3 分别为 100uF/35V (低内阻电容)

### 2. 典型应用



C1/C2/C3 100uF/35V (低内阻电容)

### 3. EMC 典型推荐电路



输入电压(VDC)		15
	C1/C2	4.7µF /50V
EMI	C3/C4	100µF /35V(低内阻电容)
	LDM	6.8µH

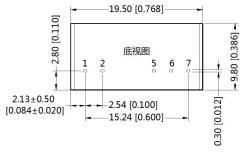
- 4. 产品输入或输出端的外接电容建议使用低 ESR 系列的电解电容
- 5. 产品不支持输出并联升功率或热插拔使用



## 外观尺寸、建议印刷版图



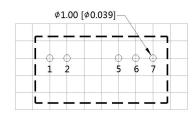
4.10 [0.161]



0.50 [0.020]

注: 尺寸单位:mm[inch] 端子截面公差:±0.10[±0.004] 未标注公差:±0.25[±0.010]





注: 栅格距离为2.54\*2.54mm

引脚方式		
引脚	功能	
1	Vin	
2	GND	
5	-Vo	
6	0V	
7	+Vo	

#### 注:

- \_ 1. 包装包编码: 58200134V;
- 2. 使用时连接电源模块和 SIC 驱动器的引线尽可能的短;
- 3. 输出滤波电容尽可能靠近电源模块和 SIC 驱动器;
- 4. SIC MOSFET 驱动器专用电源门极驱动电流的峰值较高,建议电源模块输出滤波电容选用低内阻电解电容;
- 5. 驱动器平均输出功率必须小于电源模块输出功率;
- 6. 如用于振动场合,请考虑在模块旁边用胶水固定;
- 7. 最大容性负载应在输入电压范围、满负载条件下测试;
- 8. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25°C,湿度<75%RH,标称输入电压和输出额定负载时测得;
- 9. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
- 10. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标,具体情况可直接与我司技术人员联系;
- 11. 产品涉及法律法规:见"产品特点"、"EMC 特性";
- 12. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放,并交由有资质的单位处理。